
2SC1212 , 2SC1212A

シリコン NPN エピタキシャル形

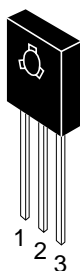
HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用

外観図

TO-126 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SC1212	2SC1212A	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	50	80	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	50	80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	4	V
コレクタ電流	I_C	1	1	A
許容コレクタ損失	P_C	0.75	0.75	W
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	8	8	W
接合部温度	T_j	150	150	
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	-55 ~ +150	

【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

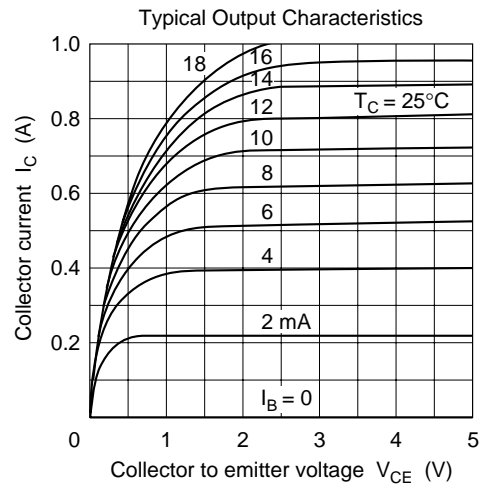
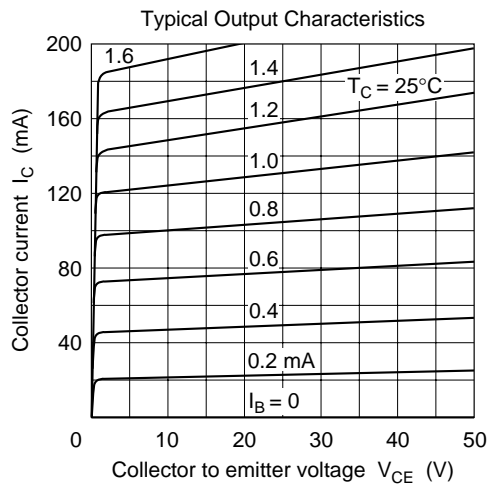
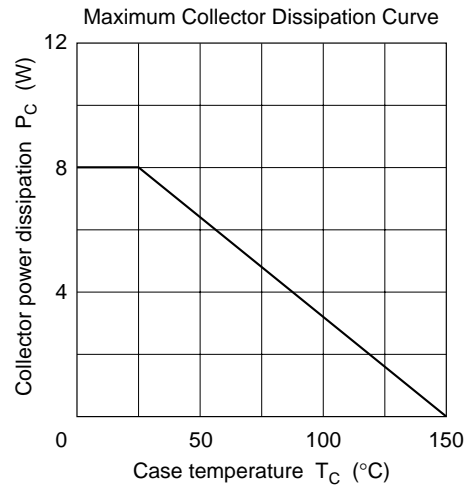
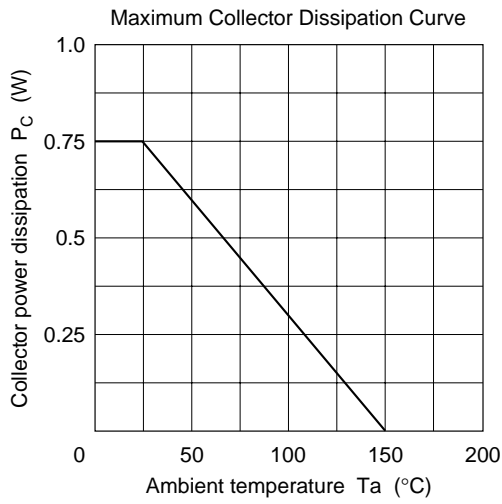
電気的特性

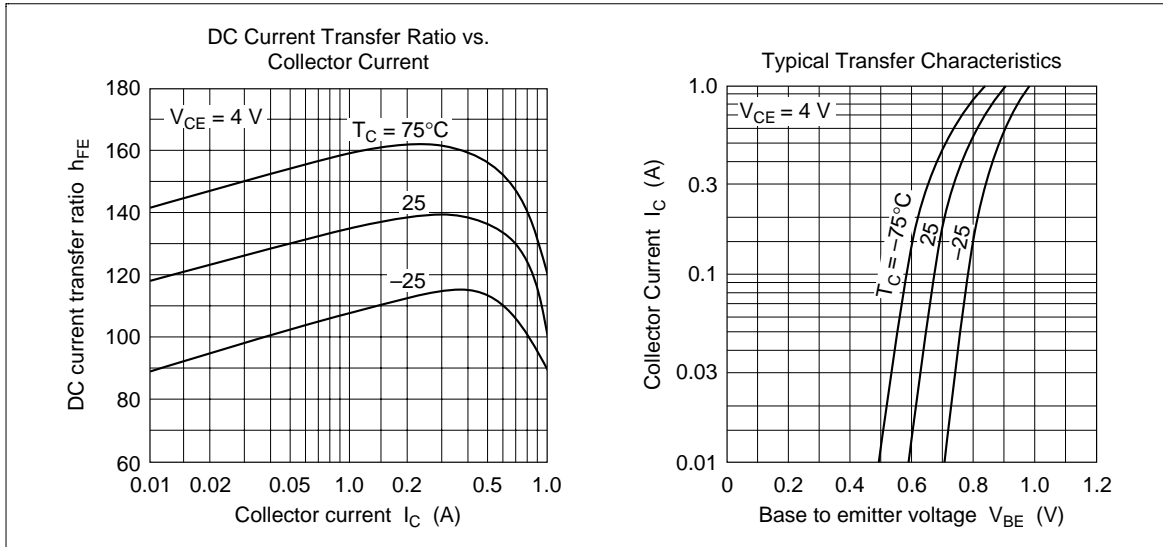
(Ta = 25)

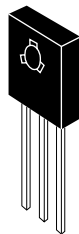
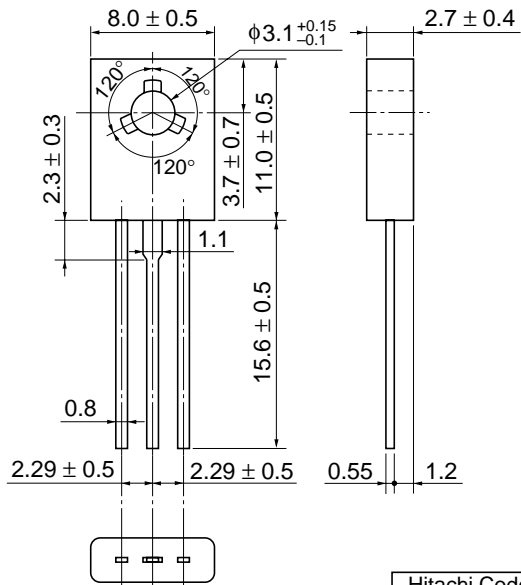
項目	記号	2SC1212			2SC1212A			単位	測定条件
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	50	—	—	80	—	—	V	$I_C = 1mA, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	50	—	—	80	—	—	V	$I_C = 10mA, R_{BE} =$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	4	—	—	4	—	—	V	$I_E = 1mA, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	5	—	—	5	μA	$V_{CB} = 50V, I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	60	—	200	60	—	200		$V_{CE} = 4V, I_C = 50mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	20	—	—	20	—	—		$V_{CE} = 4V, I_C = 1A$ (pulse test)
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	0.65	1.0	—	0.65	1.0	V	$V_{CE} = 4V, I_C = 50mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.75	1.5	—	0.75	1.5	V	$I_C = 1A, I_B = 0.1A$ (pulse test)
利得帯域幅積	f_T	—	160	—	—	160	—	MHz	$V_{CE} = 4V, I_C = 30mA$

【注】 1. 2SC1212, 2SC1212A は, h_{FE} の値により下記のように 2 区分し, 現品に表示してあります。

B	C
60 ~ 120	100 ~ 200







Hitachi Code	TO-126 Mod
JEDEC	—
EIAJ	—
Weight (reference value)	0.67 g